



応用物理学会 薄膜・表面物理分科会、シリコンテクノロジー分科会 共催

「電子デバイス界面テクノロジー研究会

—材料・プロセス・デバイス特性の物理—(第23回)

半導体デバイスの研究開発において、構造、材料の革新が進んでいます。ロジックLSIでは、FIN構造やナノワイヤ型に代表される立体構造や新しい高移動度チャンネル材料を用いたトランジスタ開発が活発に進められています。パワーデバイスにおいては、SiCやGaNデバイスの開発が進み、新しい展開が始まっています。これら様々なデバイスで性能の鍵を握るのが界面テクノロジーです。異種材料界面の科学的な理解はデバイス研究開発に不可欠なものとなっています。本研究会は産・官・学の第一線の研究者がデバイス界面に関する様々なテーマについて基礎から応用までを理論と実験の両面から議論し、本分野の発展に貢献することを目的としています。本研究会は1996年から2015年まで20回にわたり開催されてきた「極薄シリコン酸化膜の形成・評価・信頼性研究会」、「ゲートスタック研究会 —材料・プロセス・評価の物理—」の歴史を継承し、前々回より一層スコープを広げ、新たな名称のもとスタートしました。国内外からの招待講演者のほかに、一般の口頭発表とポスター発表を広く募集して開催します。さらに研究会前日にはチュートリアルを開催します。奮ってご参加下さい。

1. 日時: 2018年1月19日(金)~20日(土)。前日(18日)の夜に、チュートリアルを実施。
2. 場所: 東レ総合研修センター; 〒411-0032 静岡県三島市末広町21-9, Tel:055-980-0333 Fax:055-980-0350
http://www.toray.co.jp/network/loc_004.html

3. 招待講演者(敬称略):

<p>I 基調講演</p> <ul style="list-style-type: none"> ・赤堀 浩史(東芝メモリ) 「ビッグデータの活用によるメモリ製造革新(仮)」 ・日高 秀人(ルネサスエレクトロニクス株式会社) 「MCUイノベーションと組み込みシステムのロードマップ (エンベデッドデバイスの果たす役割)」 <p>II 招待講演</p> <ul style="list-style-type: none"> ・萬西 誠也(北大)「生体機能に倣ったゆらぎと共存協調する電子デバイス」 ・浜屋宏平(阪大)「半導体スピントロニクスにおける強磁性体/半導体ヘテロ界面の重要性」 ・小林正治(東大)「Technology break-through by ferroelectric HfO₂-based material」 	<p>他1名を予定</p> <p>III 企画セッション</p> <p>「ポストディープリンングに向けたニューロチップの基盤技術」 青野 真士(慶大)、森江 隆(九大)、他2名を予定 特別海外招待講演を予定</p> <p>IV チュートリアル</p> <p>講師1名を予定</p>
--	--

4. 参加費および宿泊費(消費税込):

- 参加費(含資料代): 薄膜及びSiテクノロジー分科会会員 15,000円, 応用物理学会・協賛学協会会員 19,000円, 一般 24,000円, 学生 8,000円
※但し薄膜及びSiテクノロジー分科会賛助会社の方は分科会会員扱い, 応用物理学会賛助会社の方は応用物理学会会員扱いとします。
- 宿泊費: 前日(19日)宿泊費(初日朝食付): 8,000円, 初日(20日)宿泊費(2日目朝食, 初日および2日目の昼食付): 9,500円。
宿泊は個室となります。宿泊されない方が昼食(両日共)を希望される場合, 事前申し込みによりお受け可能です。

5. 定員: 200名(ただし宿泊定員は150名。満員になり次第締切ります。)

6. 申込手続および締切:

- 一般講演申込(口頭発表またはポスター発表), 締切: 2017年10月23日(月)
申込先: <http://home.hiroshima-u.ac.jp/oxide/>
上記 Web site の指示に従って, 発表題目, 発表者氏名(共著者名含む)および連絡先(住所, TEL, FAX, e-mail)を日本語・英語併記し, 発表概要を和文 1000文字以内または英文 500ワード以内にまとめて, 入力して下さい。また, 口頭あるいはポスター発表のご希望には, 必ずしも添えない場合があることを予めご承知お下さい。
- 参加申込(上記 Web site にてお申込下さい。), 締切: 2017年12月11日(月) (1)参加者名 (2)性別 (3)連絡先(住所, TEL, FAX, e-mail) (4)参加費種別(会員の方は会員番号)・金額 (5)参加費振込予定日 (6)前日(1月18日)宿泊希望の有無 (7)初日(1月19日)宿泊希望の有無を明記してください。

費用は, 参加費・前日泊も含むすべての宿泊費を同時にまとめて下記口座に参加者名で1月10日までにお振り込み下さい。
参加費等の振込先: 三井住友銀行 本店営業部(本店可) 普通預金 9474715 (社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会
参加費お振り込みの際は, 受付番号および氏名カナを振込名義人欄にご入力ください。例: 5001 オウブツタロウ
所属先から複数名の方々の参加費をお振り込みの際には, 受付番号のみご入力ください。例: 5001 5003 5007
なお, 申込後の取り消しや不参加の場合, 参加費等の払い戻しは致しません。また, 請求書の発行は致しません。
担当: 応用物理学会事務局 小田康代

7. 予稿原稿締切: 2017年12月11日(月), 4頁(A4)以内(図表およびアブストラクトを含む), 本文は日本語または英語, アブストラクトと図表およびその説明は英語として下さい。上記研究会 Web site の指示に従って, pdfファイルで送信して下さい。尚, 発表申し込み時に登録した発表題目や共著者名等を変更される場合は, 必ず Web site の指示に従って, 再入力をお願いいたします。

8. その他: 発表言語は日本語または英語, 発表用の図(OHP, ポスター)は英語

- 9. 運営体制: ◎運営委員: 浦岡 行治(奈良先端大: 運営委員長), 金田 千穂子(富士通研), 高木 信一(東大), 立花 明知(京大), 生田目 俊秀(物材機構), 野平 博司(東京都市大), 丹羽 正昭(東北大学), 宮崎 誠一(名大), 山部 紀久夫(筑波大)
◎実行・プログラム委員: 澤野 憲太郎(東京都市大: 実行委員長), 長田 貴弘(物材機構: プログラム委員長), 中塚 理(名古屋大学: 副プログラム委員長), 赤坂 泰志(東京エレクトロ), 井上 真雄(ルネサス), 遠藤 哲郎(東北大), 岡田 健治(パナソニック・タワー・ジャズ セミコンダクター), 岡本 大(筑波大), 小川 慎吾(東レリサーチセンター), 押山 到(ソニー), 角嶋 邦之(東工大), 影島 博之(島根大), 上牟田 雄一(東芝), 喜多 浩之(東大), 島本 聡(日立国際電気), 白石 賢二(名大), 杉田 義博(ソシオネクスト), 諏訪 智之(東北大), 武田 さくら(奈良先端大), 知京 豊裕(物材機構), 寺本 章伸(東北大), 中山 隆史(千葉大), 蓮沼 隆(筑波大), 東 悠介(東芝), 東脇 正高(NICT), 細井 卓治(阪大), 松下 大介(東芝メモリ), 三谷 祐一郎(東芝), 水林 亘(産総研), 久本 大(日立), 森 博子(ソシオネクスト), 矢嶋 起彬(東大), 渡邊 孝信(早大), 渡部 平司(阪大)

10. 問合わせ先: 長田 貴弘(物材機構) E-mail: NAGATA.Takahiro@nims.go.jp

11. ホームページ: <http://home.hiroshima-u.ac.jp/oxide/>

*予稿集への広告掲載を募集します(5万円/A4白黒1ページ)。詳細はお問い合わせ下さい。

協賛(依頼中): 日本物理学会, 日本化学会, 日本金属学会, 日本表面科学会, 電子情報通信学会, 電気学会, 触媒学会, 日本真空学会, 電気化学会, 表面技術協会, 日本顕微鏡学会, 日本セラミックス協会, 精密工学会